
	<p>SI5424DC-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5424DC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5424DC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 100706 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5424DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	100706 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 4.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5424DC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6A (Tc) 2.5W (Ta), 6.25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5424DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5424DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5424DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5424DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5418DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5419DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5419DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>
 <p>SI5424DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5429DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p>SI5418DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>

SI5424DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5424DC-T1-E3 Datenblatt	SI5424DC-T1-E3-Datenblätter	SI5424DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5424DC-T1-E3
SI5424DC-T1-E3 Electronic	SI5424DC-T1-E3-Komponenten	SI5424DC-T1-E3-Verteiler	SI5424DC-T1-E3-Bild	SI5424DC-T1-E3-Aktie	SI5424DC-T1-E3-Teil
SI5424DC-T1-E3 Preis	SI5424DC-T1-E3 Hersteller	SI5424DC-T1-E3 Bild	SI5424DC-T1-E3 RFQ	SI5424DC-T1-E3 Online bestellen	
SI5424DC-T1-E3 Neu	SI5424DC-T1-E3 Original	SI5424DC-T1-E3 garantiert			

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited